Кристаллографические особенности структуры мартенсита сплава Ni₄₇Mn₄₂In₁₁

© Ю.В. Калетина, И.Г. Кабанова, Н.Ю. Фролова, В.М. Гундырев, А.Ю. Калетин

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия

E-mail: kaletina@imp.uran.ru

11

(Поступила в Редакцию 4 апреля 2017 г.)

Исследована структура сплава Ni₄₇Mn₄₂In₁₁ после отжига. Показано, что при охлаждении мартенситное превращение в сплаве Ni₄₇Mn₄₂In₁₁ идет с образованием модулированного мартенсита 14*M*. Проведен кристаллографический анализ структуры мартенсита. Определены ориентационные соотношения между высокотемпературной аустенитной фазой и мартенситом, а также габитусные плоскости пластин мартенсита.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема "Структура", № 01201463331) при частичной поддержке РФФИ (проект № 16-03-00043).

DOI: 10.21883/FTT.2017.10.44969.111

1. Введение

Трехкомпонентные сплавы Гейслера на основе Ni-Mn-In относятся к многофункциональным материалам, проявляющим эффект памяти формы, магнетокалорический эффект и другие свойства в области фазовых переходов. В нестехиометрических сплавах Ni-Mn-In, как показали исследования [1-5], наблюдается сложная последовательность фазовых переходов. Сначала при понижении температуры происходит магнитный переход высокотемпературной фазы из пара- в ферромагнитное состояние. Затем реализуется мартенситное превращение с образованием антиферро- или парамагнитного мартенсита, который в области низких температур изменяет свое магнитное состояние, то есть в мартенситной фазе наблюдается магнитный переход. Температуры мартенситного перехода изменяются при отклонении от стехиометрии и легировании сплавов Гейслера [3,4].

Изучение структуры фаз — исходной (высокотемпературной) и образующейся в ходе мартенситного превращения, а также их взаимосвязи — необходимо для понимания причин, вызывающих появление тех или иных значений аномальных магнитных и механических свойств в области фазовых переходов. Однако такие структурные исследования малочисленны. Изучение кристаллографических особенностей структуры представляет интерес с точки зрения получения информации о влиянии структурного и магнитного упорядочения на функциональные характеристики сплавов Гейслера Ni–Mn–In.

Проведенные нами ранее исследования тонкой структуры сплавов $Ni_{47-x}Mn_{42+x}In_{11}$ (где x от 0 до 2) после отжига методами оптической металлографии, сканирующей и электронной микроскопии, а также рентгеноструктурным методом показали, что при замещении атомов никеля атомами марганца происходят закономерные изменения фазового состава, структуры и температуры мартенситного перехода. При охлаждении в сплаве $Ni_{47}Mn_{42}In_{11}$ наблюдается мартенситное превращение по типу $L2_1 \rightarrow 14M$ с образованием модулированной структуры мартенсита [6]. Мартенсит 14M образуется также в двухкомпонентных сплавах с высокотемпературной памятью формы типа Ni–Al, и его кристаллографические особенности исследовали, например в [7]. Но этот мартенсит образуется из аустенита с другой кристаллической решеткой — B2 или $L1_0$, без участия магнитных эффектов.

В настоящей работе проведены исследования особенностей мартенситной структуры сплава Гейслера Ni₄₇Mn₄₂In₁₁. Ее целью являлось изучение кристаллографии мартенситного превращения — определения типа мартенсита, габитусных плоскостей, ориентационных соотношений между высокотемпературной фазой и мартенситом, а также механизма мартенситного превращения, когда в процессе структурного превращения могут участвовать магнитные эффекты.

2. Методика эксперимента

Исследовали сплав $Ni_{47}Mn_{42}In_{11}$, выплавленный методом электродуговой плавки в атмосфере аргона. После выплавки сплав был подвергнут гомогенизирующему отжигу при температуре 1123 К в течение 24 h с последующим охлаждением с печью.

Структурные исследования выполнены на оптическом микроскопе "Neophot-30" на шлифах после травления. Электронно-микроскопические исследования выполняли на просвечивающем электронном микроскопе JEM-200CX и сканирующем электронном микроскопе "Quanta-200" с локальным микрорентгеноспектральным анализом в отделе электронной микроскопии ЦКП Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов ИФМ УрО РАН. Электронно-микроскопические исследования проводили на фольгах, приготовленных по стандартной методике, в режимах



Рис. 1. Структура аустенита: a — структура $L2_1$ для сплава Ni₂MnIn, b — вырезанная тетрагональная ячейка — прообраз мартенсита 14M, стрелки показывают направления спинов атомов Mn в антиферромагнитном состоянии; c — предполагаемая упорядоченная структура $L2'_1$ для сплава Ni₄₇Mn₄₂In₁₁, начало координат перенесено в атом In.

светло- и темнопольного анализов. Для идентификации фаз использовали метод микродифракции от выбранного участка. Дальнейший кристаллографический анализ мартенситной структуры проводили с использованием рассчитанных в программе "CaRine" схем электронограмм и стереографических проекций, соответствующих конкретным ориентировкам кристаллов мартенсита и аустенита.

Рентгеноструктурные исследования выполнены на модернизированном дифрактометре ДРОН-1 с усовершенствованной приставкой ГП-2, позволяющей наклонять образец с точностью до 0.1 градуса и поворачивать его в плоскости образца с точностью 0.5 градуса. Приставка снабжена устройством для нагрева и охлаждения образца. Методика рентгеновских измерений подробно приведена в [6].

3. Результаты исследования и обсуждение

В высокотемпературной области исследуемый сплав $Ni_{47}Mn_{42}In_{11}$ имеет кубическую кристаллическую решетку, упорядоченную по типу $L2_1$ фазы [8]. При охлаждении в сплаве происходит мартенситное превращение, сопровождающееся перестройкой кристаллической решетки. Установлено [6], что образуется мартенсит 14*M*.

Имеющиеся в литературе данные по параметрам кристаллической решетки мартенсита 14M различаются между собой в зависимости от состава сплава и концентрации, входящих в него, элементов. Главное различие, заключающееся в размере единичной ячейки кристаллической решетки, относится к наблюдениям сплавов разных групп: в трехкомпонентных сплавах Гейслера единичная ячейка 14M содержит 56 атомов, а в двойных сплавах типа Ni–Al, с высокотемпературной памятью формы, — 28. В обоих случаях образуется 14-слойная структура типа (52) по плотноупакованным плоскостям — {111} или {110}, в ГЦК- или ОЦК-решетках аустенита соответственно. В первом случае мартенсит образуется из аустенита со структурой $L2_1$ (упорядоченная, кубическая из 16 атомов на основе 8 ячеек ОЦК), а во втором — из аустенита со структурой $L1_0$ (упорядоченная из 8 атомов на основе ячейки ГЦК). Прообразом кристаллической решетки мартенсита 14M в обоих случаях служит вырезанная из решетки аустенита тетрагональная ячейка: в первом случае состоящая из 8 атомов — с удвоенным параметром по оси c относительно ОЦК-ячейки, а во втором — из 4 атомов, с одним параметром по оси c.

На рис. 1 представлены структура кристаллической решетки аустенита L21 для сплава Гейслера, имеющего состав Ni₂MnIn (рис. 1, a), и вырезанная тетрагональная ячейка — прообраз мартенсита 14М (рис. 1, b). Предполагается, что в исследуемом сплаве Ni₄₇Mn₄₂In₁₁, существенно отклоняющемся по составу от стехиометрического сплава Гейслера Ni₂MnIn, избыточные атомы Mn в структуре аустенита L21 замещают атомы Ni. Следует отметить, что с увеличением содержания марганца ферромагнитные свойства сплава значительно возрастают, поскольку атомы Mn имеют существенно бо́льший магнитный момент — $3.33\mu_B$, чем атомы Ni $(0.36\mu_B)$. В тетрагональной ячейке (см. рис. 1, b) стрелками показаны направления спинов атомов марганца, соответствующие антиферромагнитному состоянию, которое может привести к дополнительному магнитному упорядочению кристаллической структуры. Возможно, в сплаве Ni₄₇Mn₄₂In₁₁ имеет место также дополнительное упорядочение кристаллической структуры аустенита, связанное с замещением атомов индия атомами марганца. Например, с заменой половины смешанных In-Mn слоев атомов, перпендикулярных к оси c, на Mn слои, с формированием структуры $L2'_1$, — как показано на рис. 1, *с*.

Параметры кристаллической решетки мартенсита 14*M* в сплаве $Ni_{47}Mn_{42}In_{11}$ были ранее определены нами [6] в процессе охлаждения с помощью измеренных рентгеновским методом периодов и углов решетки: сначала для высокотемпературной фазы аустенита со структурой *L*2₁, затем — мартенсита при комнатной температуре. Полученные с учетом сдвигов (52) по



Рис. 2. Схема расположения атомов в единичной ячейке мартенсита 14*M* сплава Ni₄₇Mn₄₂In₁₁ после сдвигов по системе (52) (110)[110]: *а, b* — проекции на плоскости (001) и (010) соответственно. Параметры ячейки мартенсита: a = 0.4244 nm, b = 0.5993 nm, c = 2.9687 nm, $\beta = 97.36^{\circ}$ ($\beta' = 103.35^{\circ}$).

системе (110)[$\overline{1}10$] параметры ячейки: a = 0.4244 nm, b = 0.5993 nm, c = 2.9687 nm, $\alpha = 90.57^{\circ}$, $\beta = 97.36^{\circ}$, $\gamma = 89.24^{\circ}$ характеризуют решетку мартенсита (рис. 2, *a*, *b*), как моноклинную длиннопериодную (если пренебречь незначительными отклонениями углов α и γ от 90°). Базис единичной ячейки решетки мартенсита 14*M* (из 56 атомов), внесенный в программу "CaRine", позволил получать трехмерные изображения прямой и обратной решетки, их сечения, а также — расчетные схемы электронограмм и стереографические проекции для различных ориентаций кристалла. Интересной возможностью также является расчет профиля рентгеновских пиков отражений Брэгга по углам 2 θ (рис. 3) для мартенситного кристалла. Такой профиль наглядно характеризует особенности параметров кристаллической решетки мартенсита, который можно сравнивать с экспериментальными профилями подобных кристаллов в других сплавах.

При деформации решетки $L2_1$ исходного аустенита посредством сдвигов (5 $\overline{2}$) плотноупакованных слоев атомов в системе (110)[$\overline{110}$], можно ожидать конкретные ориентационные соотношения (ОС): (001)_{14M} || (110)_{L21}, [100]_{14M} || [$\overline{110}$]_{L21}.

Эти соотношения представлены на рис. 4, *a*, *b* стереографическими проекциями мартенсита и аустенита — $(001)_{14M}$ (см. рис. 4, *a*) и $(110)_{L2_1}$ (см. рис. 4, *b*) соответственно, которые можно использовать для прогнозирования возможных ориентаций кристаллов мартенсита, образующихся в кристалле аустенита с известной ориентацией. Заштрихованные области на проекциях показывают зоны кристаллографически неэквивалентных полюсов плоскостей или направлений. Для кубической решетки $L2_1$ аустенита, имеющей высокую степень симметрии, заштрихованная область на стереографической проекции (см. рис. 4, *a*) занимает площадь одного стереографическог полюсы $\{100\}$, $\{110\}$ и $\{111\}$. Полная проекция содер-



Рис. 3. Сплав $N_{i_47}Mn_{42}In_{11}$. Рассчитанный профиль рентгеновских пиков отражений по углам 2ϑ ($\lambda_{Cu} = 1.540562$ Å) для мартенсита 14*M*.



Рис. 4. Стереографические проекции (001) аустенита (*a*) и (010) мартенсита (*b*) при выполнении ориентационных соотношений (OC): (001)_{14M} || (110)_{L21}, [100]_{14M} || [$\overline{110}$]_{L21}. Жирным шрифтом выделены индексы полюсов плоскостей и направлений, входящих в ОС. Стрелками отмечены, выбранные при расшифровке, полюсы осей зон кристаллов *A* и *M*1 (рис. 5, *a*, *b*). Обозначения: •, • — полюсы плоскостей и направлений соответственню; \diamond — полюсы $\langle 131 \rangle_{L21}$, возможных ОЗ для кристалла *A*.

жит 24 таких треугольника, и это означает, что каждая ориентация плоскости или направления в аустените в общем случае имеет 24 эквивалентных варианта. Их может быть меньше, если соответствующий ориентации полюс лежит на границе или в вершине стереографического треугольника. В частности, плоскость сдвига в аустените {110}, имеет 6 вариантов, так как ее полюс лежит в общей вершине четырех стереографических треугольников, и таких вершин 6. Если учесть, что в каждом из 6 вариантов плоскости сдвига {110} возможны два направления сдвига — например для (110) — [110] и [110], то для формирования мартенсита 14M, существует 12 кристаллографически эквивалентных вариантов ориентации его кристалла с исходным кристаллом аустенита при выполнении заданного типа ОС. В моноклинной решетке 14М, с пониженной симметрией, зона кристаллографически неэквивалентных полюсов, как можно видеть на рис. 4, b, занимает половину площади стереографической проекции — два квадранта. Поэтому в мартенсите 14М любая ориентация имеет два кристаллографически эквивалентных варианта, которые связаны между собой поворотом на 180° вокруг оси $[010]_{14M}$, и плоскость (010) в данном случае не является плоскостью двойникования. Следует также отметить, что если для кубической решетки полюсы плоскостей и направлений с одноименными индексами совпадают между собой, то в моноклинной решетке 14М мартенсита практически нет точно совпадающих полюсов плоскости и направления с одноименными индексами, за исключением полюсов (010) и [010]. Расхождение таких полюсов различно, но максимальное из них отвечает полюсам (001) и [001] — оно составляет 7.36°.

Для кристаллографического анализа структур мартенсита 14M важно учитывать возможные эквивалентные ориентации кристаллов мартенсита и определять в их числе двойниковые варианты, для чего необходимо знать плоскости двойникования в мартенсите 14M. Основные элементы двойникования мартенсита 14M, образующегося в двухкомпонентных сплавах с памятью формы типа Ni–Al — с исходной структурой аустенита B2 или $L1_0$, — были рассчитаны по феноменологической теории в работе Мураками с соавторами [7] и экспериментально подтверждены рядом исследователей. Нам необходимо установить, насколько они применимы к мартенситу 14M в трехкомпонентных сплавах Гейслера, в частности в сплаве Ni₄₇Mn₄₂In₁₁, имеющих структуру кристаллической решетки исходного аустенита $L2_1$.

На рис. 5, а представлена структура, состоящая из двух пластинчатых кристаллов мартенсита — *M*1 и *M*2, с клиновидным участком аустенита (А) между ними. Внутри каждой пластины наблюдается полосчатый контраст, предположительно отвечающий следам плоскостей залегания дефектов упаковки мартенсита 14М — $(001)_{14M} \parallel \{110\}_{L_{2_1}}$. С учетом направления полос внутренней структуры и следов межфазных границ пластины кристаллов М1 и М2 располагаются достаточно симметрично относительно проведенной нами штрихпунктирной линии. Оба направления на рис. 5, а помечены стрелками-нормалями с цифрами 1 и 2 разного вида: утолщенной серой и тонкой черной. Видимая симметрия подсказывает, что пластинчатые кристаллы мартенсита находятся между собой в двойниковом соотношении, а штрихпунктирная линия может отвечать следу плоскости двойникования.



Рис. 5. Мартенситная структура сплава Ni₄₇Mn₄₂In₁₁: a — пластины мартенсита M1 и M2 с участком аустенита A между ними; b — микродифракция с расшифровкой рефлексов аустенита и мартенсита (стрелками отмечены неустановленные рефлексы); c, d, e — рассчитанные в "CaRine" схемы электронограмм для кристаллов аустенита и мартенсита. Обозначения: \bullet , \bullet — рефлексы мартенсита разной интенсивности; \diamond — сверхструктурные рефлексы чрезвычайно малой интенсивности.

На микродифракции (рис. 5, b) выделяется сетка из наиболее ярких рефлексов. Она хорошо соответствует одному из возможных вариантов оси зоны (ОЗ) (113) аустенита с решеткой L2₁ (см. рис. 1, *a*). Выберем, например, ориентацию аустенита с ОЗ [131]. Но есть отличие: на микродифракции (см. рис. 5, b) в сетке ярких рефлексов достаточно четко наблюдаются менее интенсивные сверхструктурные рефлексы, которых не должно быть в обратной решетке структуры L21. Такие рефлексы могут принадлежать обратной решетке аустенита с уточненной структурой $L2'_1$ для сплава Ni₄₇Mn₄₂In₁₁ (рис. 1, с). Однако, их расчетная интенсивность по программе "CaRine" (см. рис. 5, с) чрезвычайно мала, и они вряд ли могут наблюдаться на электронограмме. Возможно присутствие четких сверхструктурных рефлексов на электронограмме обязано существенному магнитному взаимодействию между атомами Мп в антиферромагнитном состоянии (см. рис. 1, b), что не учитывается в программе "CaRine".

Наблюдаемое на электронограмме (см. рис. 5, *b*) расположение сверхструктурных рефлексов для аустенита со структурой $L2'_1$ может отвечать только 8 ориентациям с O3 (113) (из общего числа 12), включая выбранную нами ориентацию — O3 [13]. На стереографической проекции аустенита (см. рис. 4, а) они отмечены символом 👌. Анализ показал, что этим ориентациям аустенита, перенесенным на проекцию мартенсита (см. рис. 4, b, достаточно близки 8 ориентировок мартенсита, с различной степенью близости к полюсам 🛇 для двух групп по 4 ориентировки — с ОЗ $(28.7.2)_{14M}$ и с ОЗ (14.7.4)_{14М}. Проведенный в "CaRine" расчет схем электронограмм показал, что обе группы ориентаций ОЗ характеризуются также достаточно близкими сетками рефлексов по отношению к сетке рефлексов аустенита с ОЗ $[1\overline{3}1]_{L2'_{1}}$. Таким образом, ориентировка кристалла мартенсита $[\overline{28}, 7, \overline{2}]_{14M}$, близкая к ориентировке аустенита ОЗ $[1\overline{3}1]$ (см. рис. 4, *a*, *b*), вполне может присутствовать на электронограмме (см. рис. 5, b) со своими рефлексами, практически совпадающими с аустенитными, из-за чего ее трудно обнаружить. Достаточно яркие рефлексы на электронограмме (см. рис. 5, b) не позволяют увидеть возможное незначительное расщепление их на аустенитные и мартенситные. Мы можем считать, что ориентировки $[1\overline{3}1]_{L2'_1}$ и $[\overline{28.7.2}]_{14M}$, принадлежат интересующим нас кристаллам аустенита и мартенсита — А и М1 (что подтвердил последующий анализ).



Соответствующие им расчетные схемы электронограмм приведены на рис. 5, *c*, *d*. На них символами \Diamond отмечены сверхструктурные рефлексы чрезвычайно малой интенсивности, которые хорошо соответствуют сверхструктурным рефлексам, четко наблюдающимся на микродифракции (см. рис. 5, *b*). Видно также, что сверхструктурные рефлексы аустенита практически накладываются на аналогичные рефлексы мартенсита, и в этих случаях также трудно наблюдать возможное расщепление рефлексов двух фаз.

Для более подробного анализа и подтверждения определенных ориентаций кристаллов аустенита (A) и мартенсита (M1) необходимо рассмотреть соответствующие

бходимо рассмотреть соответствующие $[100]_{14M}$

им стереографические проекции с осями зон в центрах. Эти проекции, построенные с помощью программы "CaRine", приведены на рис. 6, a, b с сохранением ориентаций следов плоскостей в структуре (см. рис. 5, a) и расположения рефлексов главного ряда на электронограмме (см. рис. 5, b).

Как и следовало ожидать, почти совпадающее расположение полюсов на стереографических проекциях аустенита и мартенсита (см. рис. 6, *a*, *b*) подтверждает соответствие наблюдаемых ориентационных соотношений между двумя кристаллами заданным на рис. 4, *a*, *b* мартенситным ОС: $(001)_{14M} \parallel (110)_{L2'_1}$, $[100]_{14M} \parallel [\overline{1}10]_{L2'_1}$. Важно отметить, что след от плоскостей $(010)_{14M} \parallel (001)_{L2_1}$, также входящих в ОС, соответствует направлению штрихпунктирной линии, нанесенной на изображении мартенситной структуры (см. рис. 5, *a*). Анализ проекций на рис. 6, *a*, *b* показывает, что ориентировка мартенсита с ОЗ [28.7.2]_{14M} отвечает кристаллу *M*1 (а не *M*2): утолщенная светлая стрелка "1", соответствующая в структуре (см. рис. 5, *a*) нормали к полосчатому контрасту в пластине *M*1, — с достаточной близостью на проекции (см. рис. 6, *b*) указывает на полюс плоскости залегания дефектов упаковки — (001)_{14M}.

Чтобы определить ориентировку мартенситного кристалла M2, присутствующего в структуре (см. рис. 5, a), использовали ограничивающее условие для кристалла М2. Оно состоит в том, что утолщенная стрелка "2", перенесенная со структуры (см. рис. 5, a) на его стереографическую проекцию (рис. 6, c), должна указывать, как и в случае кристалла M1, — на полюс $(001)_{14M}$. Анализ показал, что для обеспечения такого условия кристалл М2 должен быть связан с кристаллом М1 двойниковым соотношением, по одной из двух плоскостей — $(\overline{1}07)_{14M}$ или $(107)_{14M}$ (что соответствует повороту на 180° вокруг нормали к выбранной плоскости), или поворотом на 90° вокруг направления $[010]_{14M}$. В каждом из трех случаев мы получаем кристаллографически эквивалентный вариант мартенситного кристалла. Чтобы правильно выбрать один из трех вариантов мы воспользовались вторым ограничивающим условием. Оно связано с ориентацией плоскости габитуса. Структура на рис. 5, а позволяет нам определить для каждого из двух мартенситных кристаллов направление следа плоскости габитуса (или связанное с ним направление проекции нормали к плоскости габитуса на плоскость фольги). Зная ориентационное соотношение между двумя мартенситными кристаллами, мы можем определить оба направления следов габитусов в одних координатах и рассчитать по ним нормаль к плоскости габитуса, которая должна быть одинакова в двух кристаллах (без учета знаков индексов). Решение такой кристаллографической задачи позволило определить единственно возможный из указанных выше трех предполагаемых вариантов ориентации кристалла М2 — двойниковый по плоскости $(\overline{1}07)_{14M} \parallel (010)_{L2'}$ с ОЗ $[14.\overline{7}.4]$. Одновременно удалось рассчитать индексы плоскостей габитуса двух мартенситных кристаллов, которые одинаковы по типу: $(\overline{1}.0.10)_{\text{H1}}$ и $(\overline{1}.0.\overline{1}0)_{\text{H2}}$.

На рис. 5, е приведена расчетная схема электронограммы для мартенсита M2. Как видно, она характеризуется расположением своих рефлексов весьма близким к рефлексам аустенита A (см. рис. 5, c) и почти совпадающим с рефлексами мартенсита M1 (рис. 5, d). Соответствующая стереографическая проекция представлена на рис. 6, c. Видно, что утолщенная стрелка "2" указывает на полюс $(001)_{14M} \parallel \{110\}_{L2'_1}$, отвечающий плоскости внутреннего двойникования (или залегания дефектов упаковки) в пластине M2. На всех стереографических проекциях (см. рис. 6, a, b, c) жирными линиями показаны следы рассчитанных габитусных плоскостей. Таким образом, в структуре на рис. 5, a мы наблюдаем мартенситные пластины, находящиеся в двойниковом соотношении по плоскости $(\overline{107})_{14M}$. Следует отметить, что плоскость $(010)_{14M}$, след которой совпадает с нанесенной на структуре (рис. 5, *a*) штрихпунктирной линией, не является плоскостью двойникования. Эта плоскость оказалась перпендикулярной найденной плоскости двойникования $(\overline{107})_{14M}$, она, вероятно, является "плоскостью сдвига" согласно приведенной в [9] классической схеме элементов двойникования.

Следует отметить, что не все рефлексы, присутствующие на микродифракции (см. рис. 5, b), идентифицированы по принадлежности к кристаллам A и M1 и M2. Большинство их — из числа рефлексов с пониженной интенсивностью, присутствуют в сетках, но не видны изза слишком низкой расчетной интенсивности. Но есть также рефлексы — указанные малыми стрелками (см. рис. 5, b), которые не удалось связать с какой-либо конкретной сеткой из двух фаз. Эти рефлексы могут соответствовать соседней ориентировке мартенсита 14M, не вошедшей в рассмотрение.

Найденное двойниковое соотношение между мартенситными кристаллами по плоскости {107} мартенсита 14М не означает возможность такого двойникования в исследованном сплаве Ni₄₇Mn₄₂In₁₁, и мы не встречали в литературе данные об экспериментальном наблюдении {107}-двойникования в сплавах Гейслера. Однако известно, что эта плоскость была получена [7] расчетом по феноменологической теории при исследовании мартенситного превращения $L1_0 \rightarrow 14M$ в сплавах с памятью формы типа Ni-Al, — как возможная при смешанном типе двойникования в сочленениях мартенситных кристаллов по модели "алмаза" при самоаккомодации. Такой факт указывает на некоторую общность кристаллографических особенностей двух групп сплавов при мартенситном превращении, и она, безусловно, должна быть. Главное различие двух групп сплавов, обладающих памятью формы при образовании мартенсита 14М, связано с параметром аустенита с (в мартенсите параметр **b**). Если этот параметр не связан геометрически с системой сдвига (110)[110], действующей в мартенситном превращении, то кристаллогеометрические особенности мартенсита 14М в различных сплавах должны быть схожи между собой. Так, например, в сплавах со структурой Гейслера параметр с удвоен относительно базовой ОЦК-ячейки, а в двухкомпонентных сплавах одинарный. Это различие в записи плоскостей аустенита отражается в 3-ем индексе, а мартенсита — во 2-м. Что касается плоскости двойникования (107)_{14M}, то ее второй индекс равен нулю. Поэтому плоскость двойникования (107)_{14М} может быть применима не только к двухкомпонентным сплавам типа Ni-Al, но также к трехкомпонентным сплавам Гейслера.

Тем не менее, между двумя группами сплавов с памятью формы есть более глубокое различие: в трехкомпонентных сплавах Гейслера в процессе мартенситного превращения дополнительно участвуют магнитные эффекты. Их влияние на процесс образования мартенсита 14*M* может вносить свои кристаллографические особенности, которые могут быть выявлены при дальнейшем исследовании.

4. Заключение

Исследована структура сплава Ni₄₇Mn₄₂In₁₁ после отжига методами оптической металлографии, электронной микроскопии, а также рентгеноструктурным методом. Показано, что при охлаждении в сплаве Ni₄₇Mn₄₂In₁₁ наблюдается мартенситное превращение по типу $L2_1 \rightarrow 14M$ с образованием модулированной структуры мартенсита. Температура мартенситного перехода близка к температуре Кюри аустенита.

Проведен кристаллографический анализ структуры мартенсита с использованием расчетных схем электронограмм и стереографических проекций по уточненному базису ячейки кристаллической решетки с учетом экспериментально определенных параметров и максимального приближения к стехиометрическому составу сплава.

Экспериментально определены ориентационные соотношения между высокотемпературной $L2_1$ фазой и мартенситом 14*M*: (001)_{14*M*} || (110)_{L21}, [100]_{14*M*} || [$\overline{1}$ 10]_{L21}, и, отвечающие им, габитусные плоскости мартенситных пластин ($\overline{1}$.0.10)_{L21} и (1.0.10)_{L21}.

Показано, что наблюдаемый внутри мартенситных пластин полосчатый контраст отвечает плоскостям залегания дефектов упаковки: (001)₁₄ || {110}_{L21}.

Между соседними пластинами мартенсита 14M обнаружено двойниковое соотношение по плоскости $(\overline{107})_{14M}$, которая, как известно из литературы, была рассчитана с использованием феноменологической теории применительно к двухкомпонентным сплавам с памятью формы типа Ni–Al, и рассматривалась авторами как возможная плоскость двоникования смешанного типа в структуре мартенсита 14M.

Список литературы

- Y. Sutou, Y. Imano, N. Koeda, T. Omori, R. Kainuma, K. Ishida, K. Oikawa. Appl. Phys. Lett. 85, 4358 (2004).
- [2] W. Ito, Y. Imano, R. Kainuma, Y. Sutou, K. Oikawa, K. Ishida. Metall. Mater. Trans. A 38^a, 759 (2007).
- [3] Ю.В. Калетина, Е.Г. Герасимов. ФТТ 56, 1583 (2014).
- [4] Ю.В. Калетина, Е.Г. Герасимов, В.М. Счастливцев, Е.А. Фокина, П.Б. Терентьев. ФММ 114, 911 (2013).
- [5] V.D. Buchelnikov, V.V. Sokolovskiy. Phys. Met. Metallogr. 112, 633 (2011).
- [6] Ю.В. Калетина, Н.Ю. Фролова, В.М. Гундырев, А.Ю. Калетин. ФТТ 58, 1606 (2016).
- [7] Y. Murakami, K. Otsuka, S. Hanada, S. Watanabe. Mater. Sci. Eng. A 189, 191 (1994).
- [8] Х. Варлимонт, Л. Дилей. Мартенситные превращения в сплавах на основе меди, серебра и золота / Пер. с англ. Наука, М. (1980), 208 с.
- [9] М.В. Классен-Неклюдова. Механическое двойникование кристаллов. Изд-во АН СССР, М.(1960), 261 с.